(12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号



特開平6-50990

(43)公開日 平成6年(1994).2月25日

(51) lat. C1. *

識別記号

FI

技術表示箇所

GO1R 1/073

HO1L 21/66

8 8406-4X

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数1 (全4頁)

(21)出願番号

特願平4-203794

(22)出願日

平成4年(1992)7月30日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 風見 哲夫

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

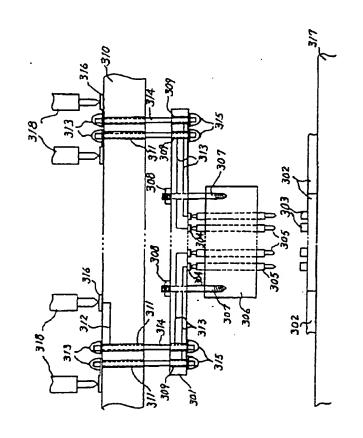
(74)代理人 弁理士 菅野 中

(54) 【発明の名称】 プローブカード

(57) 【要約】

【目的】 半導体集積回路のパッドピッテの高密度化. 多ピン化、チップ内部のパッド配置に対応したプローブ カードを容易に提供する。

【構成】 被検査チップのバッド配列で、セラミック基 板等上の金属座304にプローブ305を接続したピッ チ拡大用基板301に、パッド配列ピッテよりも広いピ ッチで、かつガラスエポキシ基板等に代表される多層基 板310に設けたスルーホール311と同じ位置にスル ーホール309を設け、両スルーホール間に金属ピン3 14を貫通させることによって、両基板間の位置決めを 行い接続する。多様なパッド配置のチップに対応するた めには、ピッチ拡大用基板のプローブ接統側金属座のバ ターンを、パッド配列に合わせて変更することによって 対応可能となる.



【特許額求の範囲】

【請求項1】 第1の多層基板と第2の多層基板とを有し、半導体集積回路のウェハ検査のために電気的信号等をチップに授受するためのプローブカードであって、第1の多層基板は、下面に被検査チップの電源・信号等のパッド配列と同配列の金属座を設け、これにプローブ針を接続し、上面に前記パッド配列のピッチよりも広いピッチで設けられた信号の電源用の金属座もしくはスルーホールを有するものであり、

1

第2の多層基板は、下面に前記金属座もしくはスルーホ 10 ール配列と同配列の金属座もしくはスルーホールを備え、上面にテスト装置と接続するための金属座を有するものであることを特徴とするプローブカード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

(産業上の利用分野)本発明はプローブカードに関し、 特に高密度・多ピンの半導体集積回路用のプローブカー ドに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の半導体集積回路のウェハ検査のた 20 めに電気的信号等をチップに授受するためのプロープカードは、図4に示すようにプローブカード基板401に 斜めに取り付けられたタングステン、パラジウム等のプローブ針402をパッドに接触させる構造のものが一般 的に使用されている。

【0003】また図5に示すように、プローブカード基板401に金属突起や微細ピン、ポゴピン等のプローブ針502を垂直に取り付けることにより、プローブとしてバッドに接触させる構造のものがある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】近年、半導体集積回路の微細化・高集積化・多ピン化に伴い、テップ内のパッドピッチが狭まる傾向にあり、このチップのウェハ検査を行うためのプローブカードも同様の傾向にある。このため、従来技術にて述べた図4の方式のプローブカードでは、ピン数の増加、パッドピッチの縮小に対し、針の取り付け位置精度が問題となり、より一層の多ピン化への対応は望めない状況にある。

[0005] また、プローブカード基板に微細ピン等をプローブとして基板に垂直に取り付ける図5に示す方式 40のプローブカードにおいては、嵌検査チップのバッド配列と同一のプローブ配列が必要となり、プローブを垂直もしくは間接的に取り付けるための基板上の金属座の配列も同様となる。

【0006】さらに、この金属座から検査装置までの信号の授受、チップの大消費電力化による電源ラインの強化のためには、プローブカード基板の微細加工及び多層化が必須となる。

(0007) しかし、現在一般的に用いられているガラスエポキシ基板に代表される多層基板の加工技術では、

半導体技術によるLSIのバッドピッチと同等の微細ピッチでの加工は、非常に困難である。またLSIのバッドピッチでの加工が可能な多層基板として、積層セラミック基板等が挙げられるが、プローブに加える圧力に対する強度や、テスト装置側接続部のピッチを確保するための基板の大型化による基板コスト上昇により、テストカ上昇につながるという問題点がある。さらに、被査チップのバッド配列の多様化に対応するためには、個々のチップのバッド配列に応じた基板の設計、製作が必要となるため、開発期間の増大及びコストのより一層の上昇という問題も加わる。

【0008】また、多ピン化、高集積化が進み、チップの内部にパッドが設けられたチップにおいては、パッド、テスト装置までの信号配線の高密度化が一次元から二次元的に進むため、この問題はより大きく顕在化してくる。

[0009] 本発明の目的は、パッドピッチの高密度化、多ピン化、チップ内部のパッド配置に対応したプローブカードを提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明に係るプローブカードは、第1の多層基板とを有し、半導体集積回路のウェハ検査のために電気的信号等をチップに授受するためので電気的信号等をチップに授受するためのでであって、第1の多層基板は、下面に被検査チップの電源・信号等のパッド配列と同配列の金属座を設け、これにプローブ針を接続し、上面に前記パッテ配列のピッチよりも広いピッチで設けられた信号の電源用の金属座もしくはスルーホールを有するものであり、第2の多層基板は、下面に前記金属座もしくはスルーホール配列と同配列の金属座もしくはスルーホールを備え、上面にテスト装置と接続するための金属座を有するものである。

[0011]

【作用】被検査チップのバッド配列で、セラミック基板 等上の金属座304にプローブ305を接続したピッチ 拡大用基板301に、バッド配列ピッチよりも広いピッ チで、かつガラスエポキシ基板等に代表される多層基板 310に設けたスルーホール311と同じ位置にスルー ホール309を設け、両スルーホール間に金属ピン31 4を質通させることによって、両基板間の位置決めを行い接続する。

[0012]

【実施例】次に本発明について図面を参照して説明する。

【0013】(実施例1)図1は、本発明の実施例1を示す構成図である。図1において、半導体集積回路のパッドピッチと同等の微細なピッチでの加工が可能な積層セラミック基板等のピッチ拡大用基板101は、一方の 60 面に被測定チップ102のパッド103の配列と同一の 、)

配列をなす金属座104を設け、その金属座104に垂 直に直接もしくは間接的にプローブの接続を行う。

【0014】本図では、プローブ及び接続方法の一例と して、両側可動のポゴピン105をブローブ針として取 り付け部材106.107.108にて金属座104に 接続した例を示している。

【0015】また、他のプローブ接続例としては、図2 に示すとおり、微細ピン205を金属座204に直接ろ う付け等によって接統した例が挙げられる。

【0016】ピッチ拡大用基板101は、他方の面に、 被検査テップ102のパッド103の配列ピッテよりも 広いピッチで金属座109を設ける。金属座109の配 列は、一般に使用されているガラスエポキシ基板に代表 される多層基板110に、信号、配線等のスルーホール 111. 内層配線112等を容易に加工可能なピッテま で広げて設ける。もしくは一般に市販されている汎用の 多層プローブカード基板110に設けられた信号、電源 配線用のスルーホール111の位置と同じ位置に設け

[0017] また、プロープ105側の金属座104と 20 多層基板110側の金属座109とは、ピッチ拡大用基 板101の内層配線113によって結線を行う。115 は半田である。

【0018】次に、多層基板110側の金属座109 に、金属ピン114を半田付け等により接続し、さらに 多層基板110のスルーホール111に貫通させること によって、多層基板110とピッチ拡大用基板101の 位置決めを行い、半田付け等によりスルーホール111 に接続する。スルーホール111から多層基板110の 内層配線 1 1 2 にて金属座 1 1 6 と接続しポゴピン 1 1 30 8 等を介してテスタ等の測定装置と接続することによ り、被検査チップと測定装置との間で信号、電源等の授 受を可能とする。117はプローバチャックトップであ

[0019] また、多様な嵌検査チップ102のパッド 103の配列に対応する場合には、多層基板110は変 更なしに、ピッチ拡大用基板101のプロープ105接 統側金属座104及び内層配線113のパターンを変更 することによって対応が可能である。

[0020] (実施例2) 図3は、本発明の実施例2を 40 106.206 取り付け用部材 示す構成図である。実施例1で設けた金属座109に代 えて、ビッチ拡大用基板301にスルーホール309を 設け、プローブ305接続側の金属座304と基板内の 内層配線313にて接続する。302は被検査チップ。 303はパッドである。

【0021】次に、スルーホール309と多層基板31 0のスルーホール311に金属ピン314を貫通させ、 半田付け等によって各基板スルーホール309.311 と金属ピン314の接続を行う。306、307、30 8は取り付け用部材、315は半田、316は金属座。

317はプローバチャックトップである.

【0022】本実施例と実施例1の相違点は、ビッテ拡 大用基板301に設けたスルーホール309と多層基板 310のスルーホール311間に金属ピン314を貫通 させることによって、多層基板310とピッチ拡大用基 板301の位置決めを行うことにある。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、嵌検査チ ップのパッド配列ピッチから、ガラスエポキシ基板に代 10 表される安価な多層基板を容易に加工可能なピッチま で、ピッチを拡大するための微細加工可能なピッチ拡大 用基板を設けたので、半導体集積回路のパッドピッチの 縮少、高密度化、多ピン化に容易に対応可能とし、さら に、ピッチ拡大基板を変更することによって、様々のパ ッド配列のテップに対応可能となる。

【0024】また、このピッテ拡大用基板と多層基板と の接続に築して、多層基板側のスルーホールに金属ピン を貫通させることによって、ピッチ拡大用基板と多層基 板との位置決めを容易に可能とする。

【0025】前記結果によって、高密度、多ピン化に対 応したプローブカードを容易に、かつ開発費の上昇を抑 えて提供するという効果を有し、また多層基板に現在一 般に市販されている汎用のプローブカード基板を流用す る、コストの低減の効果がさらに図られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1を示す構成図である。

【図2】 実施例1の別のプローブ接続例を示す図であ

【図3】本発明の実施例2に係る構成図である。

【図4】従来のブローブカードを示す構成図である。

【図5】従来のプローブカードの別の例を示す構成図で ある.

【符号の説明】

101,201,301 ピッチ拡大用基板

102,302 被検査チップ

103.303 パッド

104,204,304 被検査チップと同配列の金属

105.205.305 プローブ針

107,307 取り付け用部材

108,308 取り付け用部材

109 多層基板側ピッテの金属座

309 多層基板側ピッテの金属座スルーホール

110.310 多層基板

111, 311 スルーホール

112, 113, 312, 313 多層基板内層配線

114,314 金属ピン

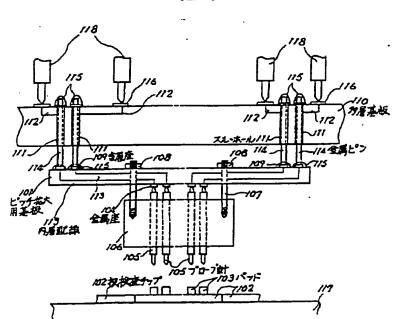
115.315 半田

50 116,316 多層基板上測定装置接線側金属座

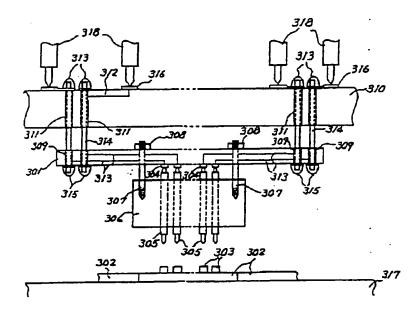
5 .

1 1 7 . 3 1 7 プローパテャックトップ 1 1 8 . 3 1 8 テスト装置接続用ポゴピン 401.501 プローブカード基板 402.502 プローブ針

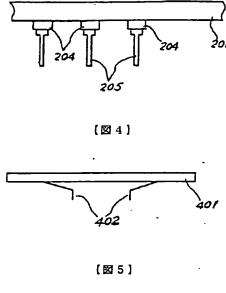
(図1)



[図3]



[図2] 小



502 502